## 母 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61-206224

@Int\_Cl\_4

G 03 F

識別記号

庁内整理番号

每公開 昭和61年(1986)9月12日

H 01 L 21/30 B 05 C 11/08

7/16

Z-7376-5F 6804-4F

6804-4F 7124-2H 審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

会発明の名称

レジスト盗布装置

**到特 顧 昭60-47026** 

官

20出 類 昭60(1985)3月8日

⑫発 明 者 木 村

伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社北伊丹製作所

内

加出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

砂代 理 人 弁理士 大岩 増雄 外2名

明細 ち

## 1. 発明の名称

レジスト歯布装置

### 2. 特許請求の範囲

- (1) 半導体ウェハの表面上に塗布ノズルからり ジスト液を摘下させると共に、同半導体ウェハを 高速回転して、摘下されたレジスト液を回転し 力により同妄面上に塗布するレジスト塗布装置に おいて、前配塗布ノズルでの複数のノズル開口の 形状、配置を、半導体ウェハの表面上で、 摘下されるレジスト 液の分布が、 面状の拡がりに なように構成させたことを特徴とするレジスト 塗布装置。
- (2) 満下されるレジスト液の分布が、円形面状の拡がりになるようにしたことを特徴とする特許 請求の範囲第1項記載のレジスト塗布装置。
- (3) 満下されるレジスト液の分布が、中央部で 様く、周縁部で厚い円形面状の拡がりになるよう にしたことを特徴とする特許請求の範囲第1項記 齢のレジスト独布装置。

## 3.発明の群組な説明

(産業上の利用分野)

この発明は半導体装置製造の際に用いられる半 導体ウェハへのレジスト強布装置に関するもので ある。

## 〔従来の技術〕

従来例によるこの種のレジスト強布装置の概要 構成を第8回に示す。この第6回においてルウ スト強布装置は、スピンモータ11と、シールハウ ジング12内で適宜シール部材13を介し、上方、取 出されるモータ軸11aの協部に固着したチャック14 に真空吸着作用を与えるための,図で3を第一の で変勢で適適する離チ15および真空チューブ 18と、前記チャック14の中心部上方、図示省略 金製引動記チャック14の中心部上方、図示省略 は、チャック18および離手18を経て、図示省略 は、から圧送されるレジスト液を噴出 は、独装置から圧送されるレジスト液を噴出 はる強布ノズル20とから構成されている。

そしてこの従来構成では、チャック14上に真空 吸着により半導体ウエハ22を保持させておき、ま ずこの半導体ウェハ22の裏面上に、第7図に示すように、盤布ノズル20からレジスト液を噴出流下させる。そしてこのようだ滴下されたレジスト液23は、その粘性による裏面受力によつて、通常, 満下中心でもある半導体ウェハ22の裏面中心に、 中央部で厚く,周辺部で薄く盛り上つた状態になる。

ついでその後、スピンモータ11により半導体ウエハ22を高速度で回転させることによつて、この半導体ウエハ22上のレジスト液23が、第8回に示すように、遠心力で薄膜状に均一に引き延ばされると共に、同レジスト液23中の溶剤成分が揮発して、その感光成分のみが半導体ウエハ22上の全面に均一な厚さで塗布されるのである。

#### (発明が解決しようとする問題点)

しかしながら前配従来例によるレジスト強布装置においては、近年での半導体ウェハの大口径化に伴なつて、次のような欠点を生ずることが明らかになつてきた。すなわち、レジスト液が半導体ウェハの中央部に盛り上つて滴下されるために、

ることができて、何ウェハの表面上にレジスト液 を全面に耳り、均一に塗布し得るのである。

## 〔実 施 例〕

以下この発明に係るレジスト塗布装置の一実施 例につき、第1図ないし第5図を参照して詳細に 説明する。

第1図実施例装置は前記第6図従来例装置に対応して表わした概要構成であつて、これらの各図中,同一符号は同一または相当部分を示し、この実施例においては、塗布ノズル17として、第2図(a),(b)に示す通り、レジスト液23を面状の拡がりで、大口径の半導体ウェハ21の表面上に満下し得るように、ノズル面で複数のノズル閉口17aを形成させたものである。

こ。で前記各ノズル開口17aの形状ならびに分布としては、適用するレジスト液23の性状とか、 大口径ウェハ21の処理条件などに対応して適宜に 選択してよいが、この実施例装置の場合。具体的 には、同第2図(b) で明らかなように、同一口径 のノズル開口17aの複数を、ノズル間で中央部分 大口径ウェハの場合には、回転途心力によるレジスト 液の引き延ばしに際して、第9回に示す通りに、レジスト液がウェハの最外縁部に到達する以前に、 その溶剤成分が揮発してしまい、大口径ウェハの全面に均一な厚さで歯布されず、また歯布むらを生ずるなどの惧れがあつた。

この発明は従来例装置でのこのような欠点を改善しようとするもので、塗布対象が大口径の半導体ウェハであつても、レジストをその全面に均一な厚さで塗布し得るレジスト塗布装置を提供することを目的とする。

#### (問題点を解決するための手段)

前記目的を達成するために、この発明に係るレジスト強布装置は、強布ノズルでの複数のノズル 関ロの形状・配置を、半導体ウェハの表面上で、 積下されるレジスト液の分布が、面状の拡がりに なるように構成したものである。

## (作用)

従つてこの発明装置の場合には、大口径ウェハの表面上に積下されるレジスト液の分布を調整す

が破,周辺部分が密になるように分布配置させた 構成にしてある。

従つて前記第2図(a),(b) に示すところの,この実施例装置による盤布ノズル17を用いた場合には、各ノズル開口17a から横下されたレジスト窓23は、第3図に見られるように、大口径ウェハ21の表面上にあつて、該当範囲内で均一な厚さの面状に拡がり、その後の大口径ウェハ21上のレジストを23は、第4図に示す通り、溶剤成分が揮発するは、原状に均一に引き延ばされ、かつ溶剤成分が揮発して、感光成分のみが均一な厚さで塗布されるのである。

なお、前記実施例装置においては、大口径ウェハ21の表面上でレジスト液23が均一な厚さの面状に落下されるようにしているが、それぞれのノズル関ロ17aの形状,分布の如何によつては、このウェハ表面上でのレジスト液23を、第5回に示すように、中央部で薄く、周録部でや、厚くなるよ

9.50 (3)

うにすることもできる。

そしてまた前記実施例では、単一の筺布ノズル 構成を用いるようにしているが、複数の塗布ノズ ル構成を用いても同様な作用効果を得られること は勿論である。

#### (発明の効果)

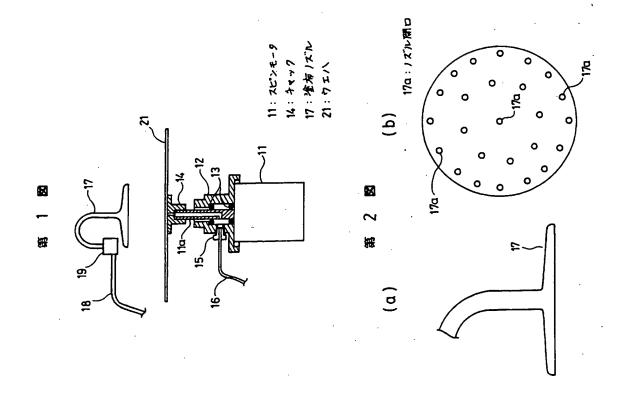
以上辞述したようにこの発明によれば、塗布オスルでの複数のノズル関ロの形状・配置を、半導体ウェハの裏面上で、橋下されるレジストをかか、面状の拡がりになるように構成したから、大口径の半導体ウェハにあつても、レジストをを全面に互り、、均一に動力などを生ずることなく塗布であるに形成し得るものである。

## 4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明に係るレジスト塗布装置の一 実施例による概要構成を示す一部縦断正面図、第 2図(a),(b) は同上塗布ノズルの正面図およびノ ズル面図、第3図は岡上レジスト液の積下状態を 示す正面図、第4図は同上レジスト塗布後の大口 径半導体ウェハを示す正面図、第5図は他の実施 例によるレジスト液の摘下状態を示す正面図であ り、また第6図は従来例によるレジスト塗布を置 の概要構成を示す一部設断正面図、第7図は同上 レジスト液の摘下状態を示す正面図、第8図およ び第9図は同上レジスト塗布後の半導体ウェハを よび大口径半導体ウェハを示すそれぞれ正面図で ある。

11・・・スピンモータ、14・・・・チャック、17・・・ 強布ノズル、17a ・・・・ノズル関ロ、21・・・・大口径 ウェハ、23・・・レジスト液。

代理人 大 岩 增 雄



# 特開昭61-206224 (4)

